

LSE

(دریافت مقاله: ۱۳۸۷/۱۱/۱؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۸۸/۱۱/۲۱)

(S) -

(FWHM)

(S)

پارامترهای تحرک پذیری، مقاومت، ثابت شبکه و گاف نواری
آلیاژ مذکور را گزارش نموده‌اند [۴].

به دلیل گستردگی گاف نواری از ناحیه مادون قرمز تا
ماورای بنفش (۰/۷-۶/۲eV) در نیمرساناهای نیتروژندار و
اهمیت آنها در کاربردهای صنعتی به‌ویژه در صنایع
اپتوالکترونیک از جمله به‌کارگیری آن در ساخت دیودهای
نورگسیل [۵-۸] که پایه تولید منابع نوری جدید می‌باشند و
به‌کارگیری آنها در ساخت قطعات توان^۱ و نیز قطعات فرکانس
بالا [۹ و ۱۰]، مطالعه این مواد و نانوساختارهای آنها هم از
جنبه نظری و هم از جنبه عملی حائز اهمیت بوده و در بسیاری
از مراکز پژوهشی مورد توجه می‌باشد.

یکی از اهداف مهم در پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به
دیودهای نورگسیل به‌ویژه LED سفید [۱۱]، رسیدن به بازده

نیمرسانای نیتروژندار، ترکیبی از عناصر گروه سوم جدول
تناوبی با عنصر نیتروژن می‌باشد که دارای ساختارهای بلوری
ورتسایتس (WZ) و زینک بلند (ZB) بوده که ساختار ورتسایتس
از نظر ترمودینامیکی پایدارتر است در حالی که ساختار مکعبی
آن در فشار بالا قابل دستیابی می‌باشد [۱ و ۲]. آلیاژهای سه
تایی و چهارتایی این نیمرساناها که از ترکیب دوتایی آنها تهیه
می‌شوند دارای ویژگی‌های منحصر بفردی‌اند که کاربردهای
گسترده‌ای در قطعات الکترونیکی و اپتوالکترونیکی دارند. برای
مثال از ترکیب نیمرسانای GaN و AlN آلیاژ $Al_xGa_{1-x}N$
به‌وجود می‌آید که x کسر مولی Al در این آلیاژ می‌باشد.
ویژگی‌های این آلیاژ از دهه ۷۰ میلادی به بعد مورد بررسی
قرار گرفت [۳] و این تحقیقات هم اکنون نیز ادامه دارد. یوشیدا
و همکارانش تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده و

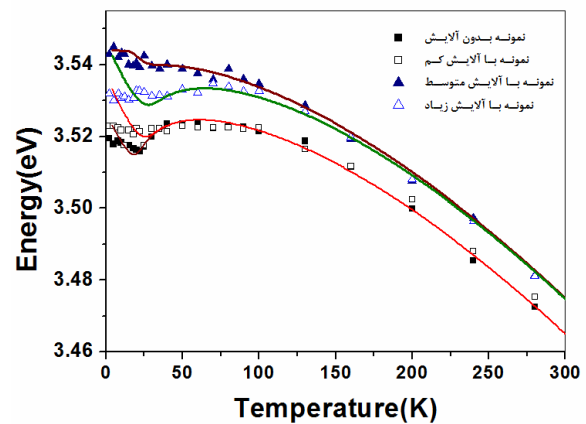
۱. Power devices

و آرایش دار را مورد مطالعه قرار دهیم. در این مقاله ابتدا نمونه‌های مورد مطالعه معرفی و به دنبال آن تغییرات دمایی طیف گسیلی نمونه‌ها بررسی می‌شود و سپس ضمن ارائه مدل LSE به تحلیل و تفسیر کمی نمونه‌ها می‌پردازیم و در انتها جمع‌بندی نتایج حاصل از این مطالعه ارائه می‌گردد.

نمونه‌های مورد مطالعه متشکل از نانو ساختار چاه‌های کوانتومی چند گانه GaN/AlGaIn می‌باشند که در روی زیر لایه اکسید آلومینیوم با جهت ترجیحی (۰۰۰۱) رشد یافته‌اند. جزئیات مربوط به ساختار نمونه‌ها و روش سنجش اپتیکی آنها در مقالات قبلی مولفین گزارش شده است [۱۳، ۱۴]. این نمونه‌ها چاه‌های کوانتومی چندگانه بدون آرایش (Undoped) و آرایش یافته (Doped) با مقادیر مختلف سیلیکون شامل نمونه‌های: آرایش کم ($3 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$)، آرایش متوسط ($4/2 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$) و آرایش زیاد ($9 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$) می‌باشند.

نقاط هندسی در شکل ۱ تغییرات دمایی قله طیف فتولومینسانس (PL) نمونه‌های چاه کوانتومی GaN/Al_{0.07}Ga_{0.93}N آرایش دار و بدون آرایش را نشان می‌دهد که به طور تجربی مورد سنجش قرار گرفته‌اند [۱۴] و خطوط توپر بر اساس مدل تئوری حالات جایگزیده ترسیم شده است که در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد. همان‌طوری که در شکل ۱ دیده می‌شود، در تمام دماها با افزایش مقدار آرایش، ابتدا قله طیف PL چاه کوانتومی به سمت انرژی بالاتر (جابه‌جایی آبی) انتقال می‌یابد که ناشی از استتار میدان‌های پیژوالکتریک داخلی به علت افزایش الکترون‌ها در چاه کوانتومی می‌باشد [۱۵] و با ادامه افزایش میزان آرایش، قله طیف PL به سمت انرژی پایین (جابه‌جایی قرمز) متمایل می‌گردد که این روند به اثر بازبهنجارش گاف نواری نسبت داده می‌شود [۱۴، ۱۶].

انرژی قله طیف PL نمونه بدون آرایش دارای جابه‌جایی قرمز - آبی - قرمز متوالی (رفتار S گونه) بوده که این رفتار به



شکل ۱. تغییرات دمایی قله طیف فتولومینسانس نمونه‌های آرایش دار و بدون آرایش (نقاط هندسی معرف داده‌های تجربی بوده و خطوط توپر بر اساس مدل تئوری LSE ترسیم شده است).

نوری بالا به منظور جایگزینی لامپ‌های روشنایی فعلی با نسل جدید منابع نوری بر پایه LED می‌باشد. وجود چگالی بالای نقایص ناشی از عدم انطباق ثابت شبکه لایه با زیر لایه در آلیاژ نیم رسانای نیتروژن‌دار به ویژه چاه کوانتومی GaN/AlGaIn، بازده نوری را کاهش می‌دهد که غالباً ناشی از به وجود آمدن مراکز باز ترکیب غیر نوری در نانو ساختارهای مربوطه می‌باشد. از طرفی جایگزیدگی اکسیتون‌ها در افت و خیزهای پتانسیل، حساسیت بازده نوری به چگالی نقایص را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر افت و خیزهای پتانسیل باعث به تله افتادن اکسیتون‌ها در حالات جایگزیده گردیده و از رسیدن آنها به مراکز غیر نوری جلوگیری می‌کند و در نتیجه افزایش بازده نوری را به همراه دارد [۱۲]. به همین جهت بررسی مسئله جایگزیدگی اکسیتون‌ها از جنبه تجربی با کمک طیف نمایی فتولومینسانس وابسته به دما دارای اهمیت زیادی است. به منظور بررسی جایگزیدگی اکسیتون‌ها مدل‌های نظری مختلفی از جمله مدل حالات جایگزیده^۱ مطرح می‌باشد که در این مقاله سعی داریم با کمک مدل مذکور داده‌های تجربی مربوط به وابستگی دمایی طیف فتولومینسانس چاه‌های کوانتومی GaN/AlGaIn بدون آرایش

۱. Localized States Ensembles (LSE)

بیرون آمدن از پتانسیل‌های عمیق و گذار به پتانسیل‌های بالاتر را به دست می‌آورند [۱۷]. بنابراین باز توزیع حرارتی اکسیتون‌ها در افت و خیزهای پتانسیل در نمونه بی آلیش منجر به رفتار S گونه می‌گردد. با افزایش میزان آلیش در نمونه، افت و خیزهای پتانسیل استتار شده و ارتفاع سد پتانسیل کاهش می‌یابد (خطوط توپر در شکل ۲) و این موجب کاهش رفتار S گونه می‌شود به طوری که در نمونه با آلیش متوسط بیشینه استتار رخ می‌دهد و رفتار S گونه تقریباً ناپدید می‌گردد (شکل ۱- مثلث توپر). همان طوری که قبلاً نیز اشاره شد با ادامه افزایش آلیش در نمونه، افت و خیزهای پتانسیل در نوار ظرفیت به دلیل ایجاد نقایص ساختاری به وجود می‌آید که این امر موجب پدیدار شدن مجدد رفتار S گونه می‌شود.

در دماهای بالا رفتار دمایی قله طیف PL تمام نمونه‌ها شبیه نیمرسانای ایده آل بوده و از رابطه تجربی و روشنی پیروی می‌کند [۱۸]

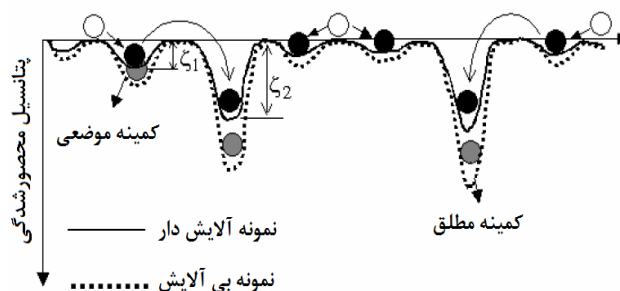
$$E_g(T) = E_0 - \alpha T^2 / (\Theta + T), \quad (1)$$

در این رابطه α و Θ به ترتیب پارامتر و روشنی و دمای دبای می‌باشند که از انطباق رابطه (۱) با داده‌های تجربی در شکل ۱ در دماهای بالا، پارامترهای مذکور برای تمام نمونه‌ها به ترتیب 0.9 meV/K و 880 K به دست می‌آیند که در توافق خوبی با مقادیر گزارش شده با گروه‌های تحقیقاتی دیگر از جمله لروکس و همکارانش دارد [۱۹].

انرژی جایگزینی اکسیتون‌ها در دمای پایین از اختلاف بین انرژی قله طیف PL و انرژی به دست آمده از رابطه و روشنی ($E_g(T)$) محاسبه می‌شود که برای نمونه‌های بی-، کم-، متوسط- و زیاد آلیش یافته به ترتیب 14 meV ، 12 meV ، 6 meV و 10 meV به دست می‌آید. این روند کاهش-افزایشی انرژی جایگزینی اکسیتون‌ها به کاهش و افزایش افت و خیزهای پتانسیل نسبت داده می‌شود. در ادامه ضمن معرفی مدل نظری حالات جایگزیده (LSE) به بررسی کمی تغییرات دمایی طیف گسیلی می‌پردازیم.

(LSE)

مدل نظری حالات جایگزیده (LSE) که براساس باز توزیع



شکل ۲. طرحواره پتانسیل محصورشدگی برای دو نمونه با میزان افت و خیز پتانسیل متفاوت (افت و خیز پتانسیل در نمونه بدون آلیش بیشتر از نمونه آلیش یافته می‌باشد). دوائر توخالی و توپر به ترتیب نماینده اکسیتون‌های غیر جایگزیده و جایگزیده هستند. فلش‌ها فرآیند ریلکس شدن اکسیتون‌ها به داخل کمیینه‌های انرژی موضعی و مطلق را نشان می‌دهند. نقاط چین مبین طرحواره نمونه با افت و خیز پتانسیل بزرگ‌تر است. ζ_1 و ζ_2 به ترتیب ارتفاع سد پتانسیل برای چاه‌هایی با پتانسیل موضعی و مطلق می‌باشند [۱۷].

جایگزینی اکسیتون‌ها در افت و خیزهای پتانسیل در چاه کوانتومی و یا فصل مشترک چاه و سد نسبت داده می‌شود. با افزایش مقدار آلیش در سد، رفتار S گونه کاهش یافته که به علت پرشدگی حالات جایگزیده ناشی از افزایش الکترون‌ها در چاه بر اثر یونیزه شدن اتم‌های سیلیکون در ناحیه سد می‌باشد و این روند تا جایی ادامه می‌یابد که رفتار S گونه تقریباً ناپدید می‌گردد. با ادامه افزایش مقدار آلیش سیلیکونی رفتار S گونه دوباره نمایان می‌شود که این امر ناشی از نقایص ایجاد شده در ناحیه سد به علت چگالی خیلی بالای آلیش سیلیکونی در سد بوده و منجر به ایجاد حالات جایگزیده در نوار ظرفیت گردیده و به دنبال آن باعث جایگزینی حفره‌ها و در نتیجه اکسیتون‌ها می‌گردد. این نتیجه از روی طیف نمایی فتولومینسانس وابسته به زمان قابل توضیح است [۱۴].

برای بررسی رفتار S گونه نمونه‌ها در دمای پایین از طرحواره باز توزیع حرارتی اکسیتون‌ها در افت و خیزهای پتانسیل نوار رسانش استفاده می‌کنیم (شکل ۲). موقعی که دمای نمونه افزایش می‌یابد ابتدا حامل‌های جایگزیده انرژی لازم برای انتقال به پتانسیل عمیق (به بزرگی ζ_1) و عمیق‌تر (به بزرگی ζ_2) را کسب می‌کنند و سپس با ادامه افزایش دما انرژی لازم برای

$$\frac{dN(E,T)}{dt} = G(E) + \gamma_c \int \frac{N(E',T)}{\tau_{tr}} e^{(E'-E_a)/k_B T} dE' \quad (3)$$

$$\times \frac{\rho(E)}{\int \rho(E) dE} - \frac{N(E,T)}{\tau_{tr}} e^{(E-E_a)/k_B T} - \frac{N(E,T)}{\tau_r}$$

در رابطه بالا از سمت راست جمله اول ($G(E)$) آهنگ تولید اکسیژن‌ها ناشی از تحریک الکتریکی یا اپتیکی می‌باشد که متناسب با تابع توزیع چگالی حالات جایگزیده است ($G(E) = k\rho(E)$ که k ثابت تناسب می‌باشد). جمله دوم آهنگ افزایش چگالی اکسیژن‌های جایگزیده به علت باز به تله افتادن اکسیژن‌ها در حالات جایگزیده را نشان می‌دهد. جمله سوم و چهارم مبین کاهش جمعیت اکسیژن‌های جایگزیده به ترتیب ناشی از برانگیخته شدن آنها با کسب انرژی دمایی (فرار از حالات جایگزیده) و باز ترکیب تابشی اکسیژن‌های جایگزیده می‌باشد. در رابطه (۲)، E_a سد پتانسیلی است که اکسیژن‌ها باید بر آن غلبه نموده تا به حالات دیگر انتقال یابند، τ_r و τ_{tr} به ترتیب زمان انتقال و زمان باز ترکیب تابشی اکسیژن‌ها هستند و γ_c ضریب (بدون بعد) باز به تله افتادن اکسیژن‌ها می‌باشد.

با اعمال شرط حالت پایا (ثابت بودن چگالی جمعیت اکسیژن‌های جایگزیده) طرف چپ معادله (۳) صفر می‌گردد و در نتیجه جواب معادله مذکور به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$N(E,T) = g(T)n(E,T). \quad (4)$$

به طوری که $g(T)$ صرفاً تابع دما و $n(E,T)$ تابع دما و انرژی بوده و از روابط زیر پیروی می‌کند:

$$g(T) = \frac{k\tau_{tr}}{(\gamma_c - 1) + (\tau_{tr}/\tau_r)\gamma_c \xi_1(T)/\Lambda}, \quad (5-الف)$$

$$n(E,T) = \rho(E)f(E,T), \quad (5-ب)$$

که در رابطه (۵-الف) $\xi_1(T) = \int_{-\infty}^{+\infty} n(E',T)dE'$

$\Lambda = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(E')dE'$ می‌باشند و در رابطه (۵-ب) $f(E,T)$ عبارت است از:

$$f(E,T) = \frac{1}{e^{(E-E_a)/k_B T} + \tau_{tr}/\tau_r} \quad (6)$$

$f(E,T)$ در رابطه بالا به عنوان تابع توزیع حالات جایگزیده می‌باشد. با توجه به شباهت بین تابع توزیع حالات جایگزیده

حرارتی حامل‌ها (مطابق شکل ۲) بنا نهاده شده، برای توصیف و تفسیر کمی رفتار دمایی قله و پهنا و سطح زیر منحنی طیف گسیل اپتیکی نیمرساناهای دارای حالات جایگزیده به ویژه نیمرساناهای نیتروژندار در محدوده دمایی پایین به کار می‌رود. این مدل اولین بار توسط لی و همکارانش در سال ۲۰۰۵ ارائه گردید [۲۰] و آنرا برای توصیف کمی تغییرات دمایی طیف گسیلی نقاط کوانتومی InGaN/GaN، InGaAs/GaAs و GaInAsN/GaAs [۲۱-۲۳] استفاده نمود. لورنکو و همکارانش در سال ۲۰۰۷ با کمک این مدل تغییرات دمایی طیف گسیلی چاه‌های کوانتومی GaAsSb/AlGaAs و GaAsSbN/GaAs را مورد بررسی قرار دادند [۱۷]. در این بخش قصد داریم ابتدا به طور مختصر به توصیف مدل LSE پرداخته و سپس با پارامترهای مهم این مدل تغییرات دمایی طیف گسیلی چاه‌های کوانتومی GaN/AlGaAs با آرایش‌های مختلف را بررسی نماییم.

همان طوری که در بخش قبل اشاره شد موقعی که دمایی نمونه افزایش می‌یابد حامل‌ها برانگیخته شده و به حالات جایگزیده منتقل می‌گردند (شکل ۲). این امر موجب باز توزیع حرارتی حامل‌های جایگزیده شده به طوری که این فرآیند روی تغییرات دمایی طیف گسیلی نمونه تأثیر می‌گذارد و در محدوده دمایی پایین رفتار غیرعادی در قله و پهنا طیف PL مشاهده می‌شود.

در آلیاژهای نیمرساناهای نیتروژندار، باز ترکیب تابشی غالب از نوع اکسیژن‌های جایگزیده بوده [۱۳-۱۶] و تابع توزیع چگالی حالات اکسیژن‌های جایگزیده به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود [۲۰]:

$$\rho(E) \propto \exp[-(E-E_a)^2/2\sigma^2], \quad (2)$$

که E_a و σ به ترتیب مرکز و پهنا طیف تابع توزیع گاوسی فوق را نشان می‌دهد. بنابراین در یک سیستم با مجموعه‌ای از حالات جایگزیده به چگالی حالات $\rho(E)$ ، آهنگ تغییر چگالی جمعیت اکسیژن‌های جایگزیده در انرژی E و دمایی T ($N(E,T)$) با توجه به باز توزیع حرارتی اکسیژن‌ها از رابطه زیر پیروی می‌کند [۲۰]:

دوم و سوم به ترتیب پهن شدگی ناشی از پراکندگی حامل‌ها به واسطه فونون‌های آکوستیکی و اپتیکی طولی می‌باشند. پارامترهای σ_A و γ_{LO} به ترتیب شدت جفت شدگی اکسیتون‌ها با فونون‌های آکوستیکی و اپتیکی بوده و $\hbar\omega_{LO}$ به انرژی فونون اپتیکی معروف می‌باشد.

سطح زیر منحنی طیف لومینسانس نیز با تعداد کل حامل‌های جایگزیده متناسب بوده و از رابطه زیر به دست می‌آید [۲۰]:

$$I(T) \propto \left\{ 1 + (1 - \gamma_c) \cdot \exp \left[\frac{(E_c - E_a) + k_B T \cdot \ln(\tau_r / \tau_{nr})}{\sqrt{(k_B T)^2 + 2(\sigma / 2.4)^2}} \right] \right\}^{-1} \quad (11)$$

خاموشی حرارتی لومینسانس^۱ از روی ضریب باز به تله افتادن (γ_c) و آهنگ فرار حرارتی اکسیتون‌های جایگزیده $(\tau_r / \tau_{nr}) e^{(E_c - E_a) / k_B T}$ قابل پیش بینی می‌باشد به طوری که نمونه‌های با ضریب γ_c کوچک‌تر و پارامتر $(\tau_r / \tau_{nr}) e^{(E_c - E_a) / k_B T}$ بزرگ‌تر دارای خاموشی حرارتی لومینسانس سریع‌تری باشند [۲۲ و ۲۳]. آهنگ فرار حرارتی حامل‌ها را می‌توان برای ارتباط آن با $E_c - E_a$ به صورت زیر باز نویسی کرد:

$$(\tau_r / \tau_{nr}) e^{(E_c - E_a) / k_B T} = (\tau_r / \tau_{nr}) e^{(E_c - E_a) / k_B T} e^{(E_c - E_a) / k_B T} \quad (12)$$

در رابطه بالا $(\tau_r / \tau_{nr}) e^{(E_c - E_a) / k_B T}$ را با پارامتر C نشان داده و آنرا پارامتر خاموشی نمونه می‌نامیم به طوری که نمونه با پارامتر C بزرگ‌تر دارای خاموشی حرارتی لومینسانس سریع‌تری باشد. با یکسان فرض نمودن τ_r برای نمونه‌ها، و با توجه به اینکه مقدار پارامتر τ_r / τ_{nr} در محاسبات مشخص می‌باشد، با باز نویسی پارامتر C به صورت $(\tau_r / \tau_{nr}) e^{(E_c - E_a) / k_B T}$ ، خاموشی حرارتی لومینسانس نمونه‌ها برحسب $1 / \tau_r$ قابل مقایسه می‌باشد.

حال مدل LSE را برای دو حالت خاص مورد بررسی قرار

می‌دهیم:

الف) برای حالت $\sigma = 0$ (چگالی حالت با تابع دلتای دیراک)،

تابع توزیع فرمی - دیراک می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم نزدیکی بین E_a و تراز فرمی وجود دارد به طوری که تمام حالات جایگزیده با انرژی کمتر از E_a در دمای صفر کلویین اشغال شده‌اند. موقعیت E_a نسبت به E_c روی رفتار دمایی طیف گسیلی سیستم‌های فیزیکی تأثیر می‌گذارد [۲۳]. در محاسبات بالا مقادیر τ_r و τ_{nr} صرفاً به نمونه مورد مطالعه بستگی داشته و از وابستگی دمایی آنها چشم پوشی شده است.

از روی رفتار دمایی $N(E, T) / \tau_r$ یا معادل آن $n(E, T)$ تغییرات دمایی شکل طیف لومینسانس حالات جایگزیده و در نتیجه تغییرات دمایی قله، پهنای و سطح زیر منحنی طیف گسیلی ناشی از حالات جایگزیده شبیه سازی می‌شوند. با کمک $\partial n(E, T) / \partial t = 0$ ، موقعیت قله تابع $n(E, T)$ در دماهای مختلف از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$E = E_c - x(T) k_B T \quad (7)$$

در رابطه بالا $x(T)$ ضریب بدون بعد وابسته به دما بوده که مقدار آن از حل عددی معادله زیر به دست می‌آید:

$$x e^x = \left(\frac{\tau_r}{\tau_{nr}} \right) \left[\left(\frac{\sigma}{k_B T} \right)^2 - x \right] e^{(E_c - E_a) / k_B T} \quad (8)$$

معادله قبل صرفاً یک جواب در محدوده $0 < x < (\sigma / k_B T)^2$ دارد. بستگی دمایی در رابطه (۷) صرفاً ناشی از توزیع حرارتی اکسیتون‌ها به حالات جایگزیده در دمای پایین بوده که از ترکیب آن با رابطه ورشنی می‌توان تغییرات دمایی قله طیف گسیلی را مطابق رابطه زیر در دماهای مختلف به دست آورد:

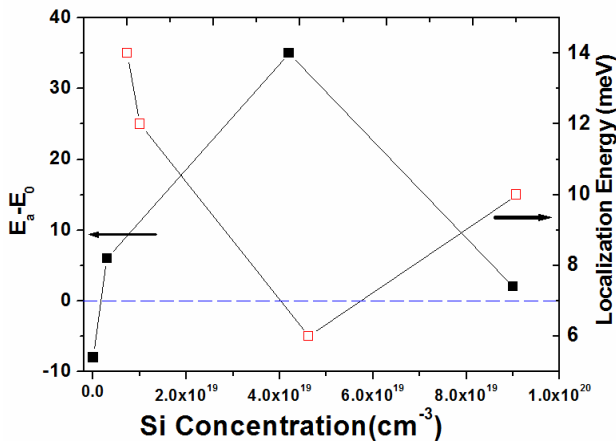
$$E = E_c - \alpha T^2 / (\Theta + T) - x(T) k_B T \quad (9)$$

تغییرات دمایی پهنای طیف (FWHM) شامل دو بخش می‌باشد: بخش اول ناشی از حالات جایگزیده در دماهای پایین بوده که از حل عددی معادله $n(E, T) = n(E_p, T) / 2$ به دست می‌آید (E_p) انرژی قله تابع $n(E, T)$ می‌باشد) و بخش دوم ناشی از پراکندگی فونون‌ها و همچنین نقایص شبکه و ناخالصی‌ها بوده که از رابطه زیر پیروی می‌کند [۲۴]:

$$\Gamma(T) = \Gamma_0 + \sigma_A T + \frac{\gamma_{LO}}{e^{\hbar\omega_{LO} / k_B T} - 1} \quad (10)$$

در رابطه بالا، جمله اول پهن شدگی طیف گسیلی ناشی از پراکندگی حامل‌ها از نقایص شبکه و ناخالصی‌ها بوده و جمله

۱. Thermal quenching of luminescence



شکل ۳. تغییرات $E_a - E_0$ (طرف چپ) و انرژی جایگزیدگی اکسیژن‌ها (طرف راست) نسبت به مقدار آلایش سیلیکون در سد.

رفتار S گونه می‌باشد (شکل ۱)، به طوری که نمونه بی آلایش با داشتن کمترین مقدار $E_a - E_0$ ، بیشترین رفتار S شکل را دارد و در نمونه آلایش متوسط با داشتن بیشترین مقدار $E_a - E_0$ ، رفتار S گونه تقریباً ناپدید می‌گردد. از طرفی با افزایش مقدار آلایش، انرژی جایگزیدگی رفتار کاهش می‌یابد - افزایشی داشته که دارای روندی مشابه مقدار $E_a - E_0$ و رفتار S شکل می‌باشد (شکل ۳).

پارامتر دیگری که متأثر از مقدار آلایش می‌باشد، پارامتر σ است. با افزایش مقدار آلایش (تا آلایش متوسط) این پارامتر کاهش یافته و رفتار دمایی نمونه به سمت رفتار دمایی گاف نواری نزدیک می‌شود که این امر موید استتار افت و خیزهای پتانسیل به دلیل افزایش حامل‌ها می‌باشد ولی با ادامه افزایش مقدار آلایش، پارامتر σ افزایش یافته (جدول ۱) که این نشانه غالب شدن مجدد فرآیند باز توزیع حرارتی حامل‌ها بوده که به دلیل ظهور مجدد افت و خیزهای پتانسیل ناشی از نقایص ساختاری می‌باشد.

شکل ۴ تغییرات دمایی پهنای طیف گسیلی نمونه‌ها را نشان می‌دهد که در دمای بالا رفتاری مشابه نیمرساناهای گروه III-V از خود نشان می‌دهد به طوری که با افزایش دما، پهنای طیف گسیلی افزایش می‌یابد ولی در دمای پایین چنین رفتاری مشاهده نمی‌شود. تغییرات دمایی پهنای طیف نمونه‌ها در دماهای بالا انطباق خوبی با رابطه (۱۰) داشته و مقادیر پارامترهای انطباقی Γ و γ_{LO} در جدول ۲ آمده است. σ_A و

جدول ۱. پارامترهای انتخابی برای مدل LSE برای نمونه‌های مورد مطالعه.

نمونه	E_0 (eV)	$E_a - E_0$ (meV)	σ (meV)	τ_r / τ_{tr}
بی آلایش	۳/۵۳۵	-۸	۶	۱۰۰۰۰
آلایش کم	۳/۵۳۵	۶	۳	۲۰۰۰۰
آلایش متوسط	۳/۵۴۴	۲۰	۳	۵۰۰۰۰
آلایش زیاد	۳/۵۴۵	۲	۶/۵	۹۵۰۰

تابع فوق مدل معروف خاموشی حرارتی^۱ لومینسانس برای سیستم دو ترازوی را توصیف می‌کند [۲۵]. در حالت $\sigma = 0$ توزیع حرارتی اتفاق نمی‌افتد و سیستم عملاً توسط یک سیستم دو ترازوی هم ظرفیت توصیف می‌شود. در سیستم دو ترازوی، مقدار $E_a - E_0$ به عنوان انرژی فعالسازی حرارتی حامل‌ها می‌باشد.

ب) در دماهای بالا با اعمال شرط $\left(\frac{\tau_r}{\tau_{tr}}\right) e^{(E_0 - E_a)/k_B T} \gg 1$ مدل LSE به مدل دنباله نواری^۲ تبدیل می‌گردد [۲۶].

LSE

موقعیت قله طیف گسیلی در دماهای مختلف را می‌توان با کمک رابطه (۹) و انتخاب مناسب پارامترهای σ ، τ_r / τ_{tr} و $E_a - E_0$ با کمک مدل LSE شبیه سازی نمود. بهترین انتخاب برای پارامترهای بالا در جدول ۱ آمده است. خطوط توپر در شکل ۱ نتایج مربوط به محاسبات مدل LSE را نشان می‌دهد و انطباق نسبتاً خوبی با داده‌های تجربی دارد. در این محاسبات پارامتر ورشنی و دمای دمای ماده برای تمام نمونه‌ها به ترتیب مقادیر 0.9 meV/K و 880 K در نظر گرفته شده است.

همان طوری که قبلاً اشاره شد پارامتر E_a دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد به طوری که موقعیت آن نسبت به E_0 روی رفتار دمایی طیف گسیلی نمونه تأثیر می‌گذارد. با افزایش مقدار آلایش، مقدار $E_a - E_0$ افزایش و سپس کاهش می‌یابد (جدول ۱) که این امر به ترتیب متناظر با تضعیف و تقویت

۱. Thermal quenching model

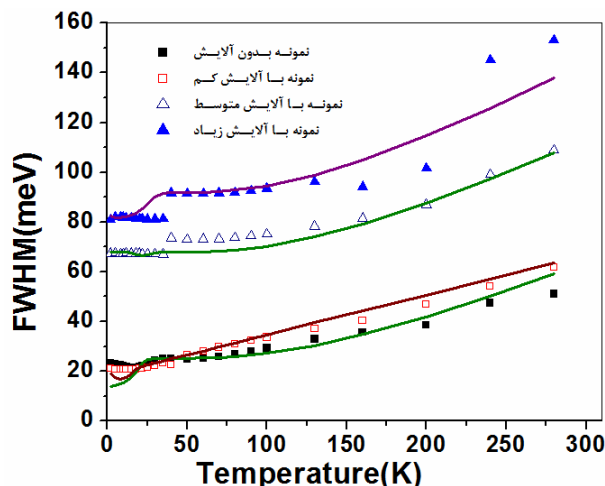
۲. Band tail model

جدول ۲. پارامترهای انتخابی جهت محاسبه پهنای طیف گسیلی برای نمونه‌های مورد مطالعه.

نمونه	Γ_0 (meV)	σ_A (meV/K)	γ_{LO} (meV)	$\hbar\omega_{LO}$ (meV)
بدون آلیش	۱۱	۰/۰۰۱۲	۱۱۰	۳۵
آلیش کم	۱۱/۵	۰/۰۰۱۲	۱۲۰	۳۵
آلیش متوسط	۶۰/۸	۰/۰۰۱۲	۱۳۰	۳۵
آلیش زیاد	۶۶/۵	۰/۰۰۱۲	۱۵۰	۳۵

مقدار کمیت τ_r / τ_{rr} برای تمام نمونه‌ها بزرگ‌تر از یک بوده و در نتیجه زمان انتقال حامل‌ها به حالات جایگزیده کمتر از زمان بازترکیب تابشی می‌باشد و بنابراین حامل‌ها قبل از بازترکیب تابشی به افت و خیزهای پتانسیل منتقل می‌گردند.

تغییرات دمایی سطح زیر منحنی طیف گسیلی نمونه‌ها با افزایش دما کاهش می‌یابد (نقاط هندسی در شکل ۵) به طوری که با افزایش مقدار آلیش، خاموشی لومینسانس کند شده (تا آلیش متوسط) و سپس تسریع می‌گردد. با قراردادن پارامترهای τ_r / τ_{rr} ، σ و $E_a - E_0$ مربوط به هر نمونه در رابطه (۱۱) و انطباق این رابطه با داده‌های تجربی، تغییرات دمایی سطح زیر منحنی طیف گسیلی هر نمونه پارامتر γ_c به دست می‌آید. این پارامتر برای نمونه‌های بدون آلیش، کم، متوسط و زیاد آلیش یافته به ترتیب $۰/۹۹۸۰$ ، $۰/۹۹۹۰$ ، $۰/۹۹۸۵$ و $۰/۹۹۸۸$ به دست می‌آید. همان طوری که قبلاً اشاره شد در نمونه‌هایی که دارای پارامتر γ_c کوچک ترمی باشند، خاموشی لومینسانس سریع تر رخ می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود که خاموشی حرارتی لومینسانس به ترتیب سریع بودن برای نمونه‌های بدون آلیش، کم، زیاد-متوسط-آلیش یافته رخ می‌دهد. مقادیر γ_c برای اغلب نمونه‌ها نزدیک ۱ بوده و اختلاف ناچیزی دارند و تأثیر این پارامتر روی خاموشی حرارتی لومینسانس نمونه‌ها قابل چشم پوشی است بنابراین پیش بینی می‌شود که پارامتر آهنگ انتقال حامل‌ها تأثیر بسزایی روی خاموشی لومینسانس نمونه‌ها داشته باشد به طوری که در نمونه‌های با آهنگ انتقال حامل بیشتر، خاموشی حرارتی لومینسانس سریع تر اتفاق می‌افتد.

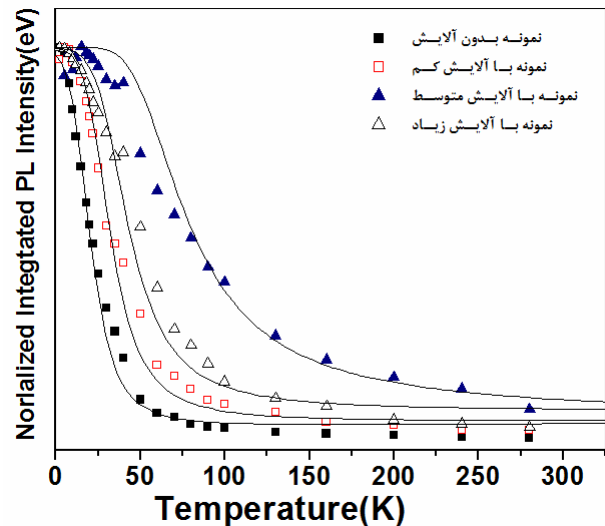


شکل ۴. تغییرات دمایی پهنای طیف فتولومینسانس نمونه‌های آلیش دار و بدون آلیش (نقاط هندسی معرف داده‌های تجربی بوده و خطوط توپر براساس مدل تئوری LSE و رابطه (۱۰) ترسیم شده است).

در اغلب نیم‌رساناهای نیتروژندار به ترتیب $\hbar\omega_{LO}$ در ۳۵ meV و $۰/۰۰۱۲$ meV/K در نظر گرفته شده است [۱۱ و ۱۲]. تغییرات دمایی پهنای طیف نمونه‌ها در دمای پایین از رابطه (۱۰) منحرف شده و از پهنای طیف لومینسانس حالات جایگزیده $n(E,T)$ ناشی از جایگزیدگی اکسیتون‌ها پیروی می‌کند. خطوط توپر در شکل ۴ نتایج مربوط به پهنای حاصل از ترکیب رابطه (۱۰) و پهنای ناشی طیف لومینسانس حالات جایگزیده را نشان می‌دهد. پهنای طیف گسیلی اغلب نمونه‌ها در دماهای پایین تقریباً ثابت بوده و از دمای ۴۰ K به بعد یکباره افزایش می‌یابد و از رابطه (۱۰) پیروی می‌کند. پهنای که از مدل LSE برای دماهای پایین به دست می‌آید برای نمونه‌های کم- و زیاد-آلیش یافته انطباق نسبتاً خوبی داشته و برای نمونه‌های بدون آلیش و متوسط-آلیش یافته انطباق کمی دیده می‌شود که این عدم انطباق برای نمونه بدون آلیش ناشی از عمق زیاد افت و خیزهای پتانسیل می‌باشد در حالی که در نمونه با آلیش متوسط رفتار خاصی مشاهده شده که با روند کلی تغییرات در نمونه‌های دیگر هماهنگی لازم را ندارد و در حال حاضر دلیل قانع کننده‌ای برای آن نمی‌توان ارائه داد (شکل ۴).

وجود حالات جایگزیده در چاه کوانتومی به دلیل وجود افت و خیزهای پتانسیل در چاه کوانتومی و یا در فصل مشترک چاه و سد (تا مقدار آرایش متوسط) و نقایص موجود در ناحیه سد (در آرایش بالا) می باشد. تغییرات دمایی طیف گسیلی نمونه بدون آرایش و آرایش دار با کمک مدل حالات جایگزیده (LSE) قابل بررسی بوده و با استفاده از پارامترهای معرفی شده در این مدل مانند σ ، τ_r / τ_{nr} ، و $E_a - E_s$ رفتار دمایی نمونه‌ها به خوبی قابل توصیف است. با توجه به مقدار پارامتر $E_a - E_s$ می توان رفتار S گونه نمونه‌ها را پیش بینی کرد به طوری که نمونه بدون آرایش با کمترین $E_a - E_s$ و نمونه با آرایش متوسط با بیشترین $E_a - E_s$ به ترتیب قوی ترین و ضعیف ترین رفتار S گونه را دارا می باشند. پارامتر پهنای چگالی حالات جایگزیده (σ) با میزان استتار افت و خیزهای پتانسیل رابطه معکوس دارد یعنی نمونه آرایش یافته نسبت به نمونه بدون آرایش با داشتن کمترین مقدار σ دارای بیشترین استتار افت و خیزهای پتانسیل هستند. نسبت زمان بازترکیب تابشی به زمان انتقال حامل‌ها برای تمام نمونه‌ها بزرگتر از یک بوده و در نتیجه حامل‌ها قبل از بازترکیب به حالات جایگزیده منتقل می گردند. بین پارامترهای ضریب باز به تله افتادن و آهنگ انتقال حامل‌ها، پارامتر اخیر تأثیر بیشتری را روی خاموشی حرارتی لومینسانس نمونه‌ها دارد. این بدان معنی است که نمونه بدون آرایش با بزرگترین آهنگ انتقال حامل و نمونه متوسط آرایش یافته با کمترین آهنگ انتقال حامل به ترتیب دارای سریعترین و کندترین خاموشی حرارتی لومینسانس می باشند.

مولفان از آقای پرفسور هیروشی آمانو و همکارانش در دانشگاه میجو ژاپن برای تهیه نمونه‌ها و دکتر لی و همکارانش از دانشگاه هنگ کنگ به خاطر همکاری صمیمانه علمی سپاسگزاری می نمایند.



شکل ۵. تغییرات دمایی سطح زیرمنحنی طیف فتولومینسانس نمونه‌های آرایش دار و بدون آرایش (نقاط هندسی معرف داده‌های تجربی بوده و خطوط توپر با انطباق رابطه 1° با داده‌های تجربی و انتخاب مناسب پارامتر γ ترسیم شده است).

به عنوان مثال پارامتر خاموشی برحسب $1/\tau_r$ در دمای 100K با توجه به پارامترهای τ_r / τ_{nr} و $E_a - E_s$ برای نمونه‌های بدون آرایش، کم، متوسط و زیاد آرایش یافته به ترتیب مقادیر $7/92 \times 10^3$ ، $4/88 \times 10^3$ ، $9/95 \times 10^3$ ، $2/53 \times 10^4$ این مقادیر نشان می دهد که خاموشی حرارتی لومینسانس نمونه‌ها در دمای 100K به ترتیب سریع بودن به صورت زیر می باشد: بدون آرایش، کم، زیاد- و متوسط- آرایش یافته که با داده‌های تجربی (شکل ۵) در توافق است.

با افزایش آرایش در چاه کوانتومی چند گانه GaN/AIGaN ابتدا انرژی قله طیف فتولومینسانس به سمت انرژی‌های زیاد و سپس به سمت انرژی‌های کم جابه‌جا می شود و همچنین پهنای طیف افزایش و سپس کاهش می یابد (در دمای پایین). این روند به علت

Nitride Semiconductors and Devices, ed. by H Morkoc, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, (1999), Springer Series in Materials Science, Vol. 32.

1. B Gil, *Group III Nitride Semiconductor Compounds: Physical and Applications*, Oxford Univ. Press, New York (1998).
2. R Hull, R M Osgood, Jr. H Sakaki and A Zunger,

- Iwaya, H Amano and I Akasaki, *Phys. Stat. Sol. (a)* **201** (2004) 2251.
14. H Haratizadeh, P P Paskov, G Pozina, P O Holtz, and B Monemar, *Appl. Phys. Lett.* **80** (2002) 1373.
 15. M Gallart, A Morel, T Taliercio, P Lefebvre, B Gil, J Allègre, H Mathieu, N Grandjean, M Leroux, J Massies, *Phys. Stat. Sol. (a)* **180** (2000) 127.
 16. F Bernardini, V Fiorentini, and D Vanderbilt, *Phys. Rev. B* **56**, (1997) R10024.
 17. S A Lourenco, I F L Dias, J L Duarte, E Laureto, V M Aquino, and J C Harmand, *Brazilian Journal of Physics* **37** (2007) 1212.
 18. Y P Varshni, *Physica* **34** (1967) 149.
 19. M Leroux, N Grandjean, B Beaumont, G Nataf, F Semond, J Massies and P Gibart, *J. Appl. Phys.* **86** (1999) 3721.
 20. Q Li, S J Xu, M H Xie and S Y Tong, *Euro. Phys. Lett.* **71** (2005) 994.
 21. Q Li, S J Xu, W C Cheng, M H Xie, S Y Tong, C M Che and H Yang, *Appl. Phys. Lett* **79** (2001) 1810.
 22. Z F Wei, S J Xu, R F Duan, Q Li, J Wang, Y P Zeng and H C Liu, *J. Appl. Phys* **98** (2005) 084305.
 23. Z F Wei, S J Xu and Q Li, *J. Appl. Phys* **100** (2006) 124311.
 24. J V D Veliadis, J B Khurgin, Y J Ding, A G Cui, and D S Katzer, *Phys. Rev. B* **50** (1994) 4463.
 25. D Curie, *Luminescence in Crystals*, Methuen, London (1963) 206.
 26. P G Eliseev, P Perlin, J Lee and M Osiński, *Appl. Phys. Lett.* **71** (1997) 569.
 3. J Hagen, R D Metcalfe, W Clark, and D Wickenden, *J. Phys. C: Solid State Phys.* **11** (1978) L143.
 4. S Yoshida, S Misawa, and S Gonda, *J. Appl. Phys.* **53** (1982) 6844.
 5. I Akasaki, H Amano, K Itoh, H Sakai, T Tanaka and K Manaba, *Inst. Phys. Conf. Ser.* **129** (1992) 851.
 6. S Nakamura, T Mukai and M Senoh, *Appl. Phys. Lett.* **64** (1994) 1687.
 7. S Nakamura and G Fasol, *The Blue Laser Diode - GaN-Based Light Emitters and Lasers*, Heidelberg: Springer-Verlag (1997).
 8. G A Smith, T N Dang, T R Nelson, J L Brown, D Tsvetkov, A Usikov, V Dmitriev, *J. Appl. Phys.* **95** (2004) 8247.
 9. J K Gillespie, R C Fitch, N Moser, T Jenkins, J Sewell, D Via, A Crespo, A M Dabiran, P P Chow, A Osinsky, M A Mastro, D Tsvetkov, V Soukhoveev, A Usikov, V Dmitriev, B Luo, S J Pearton, F Ren, *Solid State Electronics* **47** (2003) 1859.
 10. M J Manfra, N G Weimann, O Mitrofanov, T Waechtler, D M Tennant, *Phys. Stat. Sol. (a)* **200** (2003) 175.
 11. S Chichibu, K Wada, S Nakamura, *Appl. Phys. Lett.* **71** (1997) 2346.
 12. T Okimoto, M Tsukihara, K Kataoka, A Kato, K Nishino, Y Naoi and S Sakai, *Phys. Stat. Sol. (c)* **5** (2008) 3066.
 13. B Monemar, P P Paskov, H Haratizadeh, J P Bergman, E Valcheva, V Darakchieva, B Arnaudov, T Paskova, P O Holtz, G Pozina, S Kamiyama, M

Archive